



DAYA

臺源國際股份有限公司

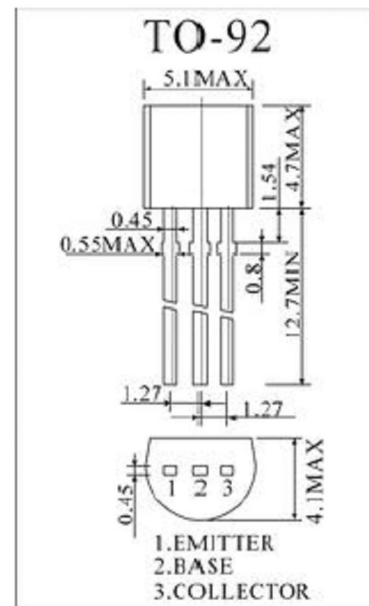
9014

TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

— NPN silicon —

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V _{CB0}	50	V
集电极-发射极电压	V _{CE0}	45	V
发射极-基极电压	V _{EB0}	5	V
集电极电流	I _c	100	mA
集电极耗散功率	P _c	400	mW
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



■电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	60		1000		V _{CE} = 5 V, I _c = 1 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			0.1	μ A	V _{CB} = 50V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			0.1	μ A	V _{EB} = 5 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	50			V	I _c = 0.1mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CE0}	45			V	I _c = 1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	5			V	I _E = 0.1mA, I _c =0
基极-发射极电压	V _{BE(on)}	0.58	0.63	0.7	V	V _{CE} = 5V, I _c = 2mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		0.14	0.3	V	I _c = 100mA, I _B = 10mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		0.84	1.0	V	I _c = 100mA, I _B = 10mA
电流增益-带宽乘积	f _T	150	270		MHz	I _c = 10mA, V _{CE} = 5V
共基极输出电容	C _{ob}		2.2	3.5	PF	V _{CB} = 10V, I _E =0, f= 1 MHz
噪声系数	N _F		0.9	10	dB	V _{CE} = 5V, I _c = 0.2mA, f= 1KHz, R _g = 2K Ω

■h_{FE} 分档及其标志

分 档	A	B	C	D
h _{FE}	60~150	100~300	200~600	400~1000